

ГТ115А, ГТ115Б, ГТ115В, ГТ115Г, ГТ115Д

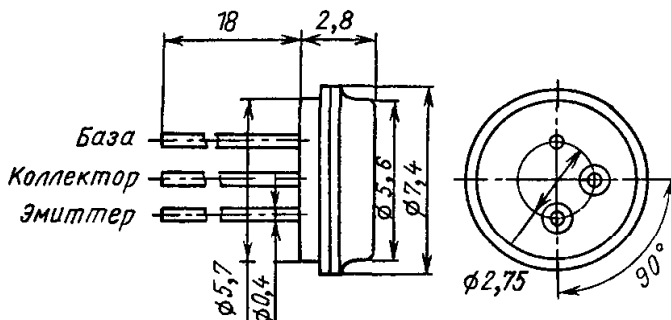
Транзисторы германиевые сплавные *p-n-p* маломощные

Предназначены для работы в качестве усилительного элемента в радиолюбительских конструкциях

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами

Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора не более 0,6 г



Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общей базой при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 5$ мА не более . . . 1 МГц

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{КБ} = 1$ В, $I_3 = 25$ мА, $f = 270$ Гц

ГТ115А, ГТ115Б 20–80

ГТ115В, ГТ115Г 60–150

ГТ115Д 125–250

Обратный ток коллектора не более:

при $U_{КБ} = 20$ В ГТ115А, ГТ115В, ГТ115Д 40 мкА

при $U_{КБ} = 30$ В ГТ115Б, ГТ115Г 40 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 20$ В не более . . . 40 мкА

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
Энергоатомиздат, 1985

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	
ГТ115А, ГТ115В, ГТ115Д	20 В
ГТ115Б, ГТ115Г	30 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	
	20 В
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	
	50 мВт
Постоянный ток коллектора	
	30 мА
Температура перехода	
	343 К
Температура окружающей среды	
	От 253 до 318 К

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
Энергоатомиздат, 1985